文章编号: 0258-7025(2010)Supplement 1-0012-04

高重复频率双调 Q Nd:YVO4激光器

冯宇彤1,2 孟俊清1 陈卫标1

(¹中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800;²华北光电技术研究所,北京 100015)

摘要 在激光二极管单端抽运结构的 Nd: YVO₄ 约激光器中,同时利用声光(AO)Q 开关和 Crⁱ⁺:YAG 可饱和吸收 体被动 Q 开关,实现 1.06 μm 激光高重复频率下(约 100 kHz)的双调 Q运转。当抽运功率为 6.1 W,重复频率为 125 kHz 时,得到了最短脉冲宽度 7 ns 的输出脉冲。同样工作条件下,腔内不插入 Crⁱ⁺:YAG 可饱和吸收体时,脉 冲宽度为 13 ns。结果表明,与 AO 调 Q 方式相比,AO-Crⁱ⁺:YAG 双调 Q 方式运转可以有效地压窄脉冲宽度。 关键词 激光器;声光调 Q;高重复频率;被动调 Q;双调 Q

中图分类号 TN 248.1 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201037s1.0012

High Pulse Repetition Rate, Doubly Q-Switched Nd: YVO₄ Laser

Feng Yutong^{1,2} Meng Junqing¹ Chen Weibiao¹

¹ Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China ² North China Research Institute of Electro-Optics, Beijing 100015, China

Abstract In this paper, we report a laser diode-end-pumped Nd: YVO₄ laser, doubly *Q*-switched by an acousto-optic (AO) *Q*-switch and a Cr^{4+} : YAG saturable absorber. At the pump power of 6.1 W and the pulse repetition rate of 125 kHz, the shortest pulse width of 7 ns is achieved. When the Cr^{4+} : YAG saturable absorber is removed from the resonator, the corresponding pulse width is 13 ns. In contrast to an AO *Q*-switched laser, it is shown that the pulse width is obviously compressed in a doubly *Q*-switched laser with AO and Cr^{4+} : YAG.

Key words lasers; acousto-optic Q-switch; high repetition rate; passive Q-switch; double Q-switch

1 引 言

激光二极管(LD)端面抽运的全固态激光器体 积小,腔内光束交叠效率高,光束质量好,并且LD 和激光晶体这两个主要的热源分离,降低了整机的 热管理难度,近年来发展十分迅速,已成为激光技术 的一个重要发展方向^[1]。本课题组采用全固态种子 激光器和光纤放大器的混合式主振功率放大 (MOPA)方式得到了平均功率20W,重复频率 150kHz,脉冲宽度15.3 ns的激光输出^[2,3]。在这 种技术路线中,重复频率和脉冲宽度两个参数由提 供信号光的全固态激光器决定,平均功率和光束质 量两个指标则通过光纤放大器实现。许多应用场合 要求保持高平均功率、高重复频率的同时,脉冲宽度 能达到10 ns以下,即要求信号光的脉冲宽度要小 于10 ns,为此,对全固态种子激光器进行了改进。

同时采用主动调 Q 和被动调 Q 技术的主被动 双调 Q 技术,近年来已有一些报道^[4~9]。声光(AO) 调 Q 激光器输出脉冲信号上升沿较陡而下降沿缓 慢,有一定的拖尾现象。而利用 Cr⁴⁺:YAG 可饱和 吸收体被动调 Q 的激光器脉冲宽度要窄许多,但由 于 Cr⁴⁺:YAG 晶体自身的激发态吸收性质,输出脉 冲序列时间稳定性低,相邻脉冲幅值抖动较大。利 用 AO Q 开关得到稳定的脉冲序列,同时利用 Cr⁴⁺:YAG可饱和吸收体压窄脉宽,可以得到稳定 脉冲序列、窄脉冲宽度的激光输出。文献[8]报道了 基于 AO-Cr⁴⁺:YAG 双调 Q 的 Nd:GdVO4 激光器, 得到 40 kHz 重复频率下,对应脉宽为 32.8 ns。文 献[9]中同样类型激光器在 10 kHz 重复频率下,脉

收稿日期: 2009-11-22; 收到修改稿日期: 2010-03-25

作者简介:冯宇彤(1982—),男,博士研究生,主要从事激光技术方面的研究。E-mail:ytfeng@mail.siom.ac.cn

导师简介:陈卫标(1969一),男,研究员,博士生导师,主要从事激光遥感技术方面的研究。

E-mail: wbchen@mail.shcnc.ac.cn

宽为 16 ns。文献[7]报道的同样双调 Q 的 Nd: YVO4激光器,得到了 10 kHz 重复频率下,脉宽 13.6 ns的输出。前述工作充分表明在单独 AO 调 Q激光器中,加入可饱和吸收体可以有效地压窄脉 宽,本文以 Nd:YVO4晶体为激光工作物质,研究了 在高重复频率(约 100kHz)下,采用 AO-Cr⁴⁺:YAG 主被动双调 Q方式的激光输出特性,在重复频率为 125 kHz 时,获得了平均功率 440 mW,脉冲宽度 7 ns的输出脉冲。

2 实验装置

实验装置如图1所示,采用结构紧凑的平-凹腔 结构, 腔长约 55 mm; 平面镜靠近抽运源的一面镀 808 nm 增透膜,靠近激光晶体的一面镀 1064 nm 高 反膜和 808 nm 增透膜;用作耦合输出镜的凹镜曲 率半径为 5000 mm, 对 1064 nm 波长透射率为 15%;抽运源为光纤耦合输出的激光二极管,发射谱 线的中心波长为 807 nm,输出光纤的数值孔径为 0.22;光纤输出光束经耦合透镜系统后的抽运光斑 直径约 200 μm,耦合效率为 90%;激光晶体是掺杂 原子数分数为 0.5%的 Nd:YVO4 晶体,尺寸为 3 mm×3 mm×6 mm,两个通光面镀 808 nm 和 1064 nm 增透膜,晶体上下底面垫铟箔置于黄铜热 沉上,热沉表面镀金以防止表面氧化减弱冷却效果; AOQ开关通光方向长度为 33 mm,两个通光面均 镀有 1064 nm 增透膜, Q 开关本征频率为 40.68 MHz, 衍射损耗 83%; Cr4+ : YAG 被动 Q 开 关置于激光晶体和 AO Q 开关之间。



图 1 双调 Q 装置图 Fig. 1 Schematic of doubly Q-switched laser

3 实验结果及分析

输出镜对 1064 nm 透射率 T=15%时,在不同 的 AO 调制频率下,对不同初始透射率的 Cr^{4+} : YAG 被动 Q 开关对输出脉冲宽度的影响效果进行 了研究,发现对于同一 AO 调制频率,初始透射率 $T_0=70\%$ 的 Cr^{4+} :YAG 被动 Q 开关对脉冲宽度的 压缩效果最为明显。图 2 给出了重复频率 125 kHz 时,不同初始透射率情况下,输出脉冲的脉冲宽度随 抽运功率的变化曲线。



图 2 125 kHz 时,不同初始透射率下脉冲宽度 与抽运功率的关系

Fig. 2 Pulse width versus pump power with different initial transmissions at 125 kHz

从图 2 可以看出,在初始透射率 $T_0 = 70\%$ 时,随着抽运功率的增大,与 AO 调 Q 相比,主被动双 调 Q 方式对脉冲宽度的压缩效果也越明显,在抽运 功率 6.1 W 时,通过 AO 调 Q 获得的脉宽是 13 ns, 而利用 AO-Cr⁴⁺ : YAG($T_0 = 70\%$)主被动调 Q 获得的脉宽仅 7 ns,相应的脉冲时序波形图如图 3 所示。



图 3 125 kHz 时双调 Q 脉冲时序波形图 Fig. 3 Doubly Q-switched pulse shape at the repetition rate of 125 kHz

图 4 是在不同 AO 调制频率下, 腔内有无Cr⁴⁺: YAG(T₀=70%)可饱和吸收体时的平均输出功率 随抽运功率的变化关系。从图 4 可以看出, 在腔内 有无 Cr⁴⁺:YAG 可饱和吸收体时, 平均输出功率都 随抽运功率的增加而增加, 但在同样抽运功率条件 下, 双调 Q 的平均输出功率明显低于单 AO 调 Q 的 输出, 这是由于 Cr⁴⁺:YAG 被动 Q 开关的残余吸收 导致的, 这相当于引入非常大的插入损耗, 并且双调 Q 时的斜率效率要低于单 AO 调 Q。

图 5 是在不同 AO 调制频率下, 腔内有无Cr⁴⁺: YAG(T₀=70%)可饱和吸收体时的脉冲宽度随抽



图 4 不同重复频率下平均输出功率与抽运功率的关系 Fig. 4 Average power versus pump power at different pulse repetition rates

运功率的变化关系。从图 5 可以看出,在相同抽运 功率下,双调 Q 和单 AO 调 Q 的脉宽都随重复频率 的增大而增大;在相同重复频率下,双调 Q 和单 AO 调 Q 的脉宽都随着抽运功率的增大而减小,并且双 调 Q 时的脉冲宽度始终小于单 AO 调 Q 时的脉冲 宽度,Cr⁴⁺:YAG 被动 Q 开关对脉宽的压缩效果随 着抽运功率的增大而增加。



图 5 不同重复频率下脉冲宽度与抽运功率的关系 Fig. 5 Pulse width versus pump power at different pulse repetition rates

图 6 是在不同 AO 调制频率下, 腔内有无 Cr^{4+} : YAG($T_0 = 70\%$)可饱和吸收体时的峰值功率随抽



图 6 不同重复频率下峰值功率与抽运功率的关系 Fig. 6 Peak power versus pump power at different pulse repetition rates

运功率的变化关系。从图 6 中可以看出,在相同抽运功率下,单 AO 调 Q 和双调 Q 的峰值功率都随着 重复频率的增大而减小,并且其差值也随着重复频 率的增大而减小;在相同重复频率下,双调 Q 和单 AO 调 Q 的峰值功率都随着抽运功率的增大而增 大,并且其差值也随着抽运功率增大而增大。

此外,从图 4 中还可以看出,当重复频率在 约 100 kHz时,不论腔内有无 Cr⁴⁺:YAG 晶体,不 同的调制频率对应的平均输出功率曲线都相差不 大,这是由于 Nd:YVO4 晶体工作在高重复频率条 件下时,其平均输出功率已经接近连续性能,在实验 中,当 AO 调制频率高于 100 kHz 后,平均输出功率 就基本不变,这与文献[7~9]中调制频率仅几十千 赫兹的情形不同。在这种工作状态下,相同抽运功 率时的单脉冲能量随着重复频率的增加而减小。



图 7 Cr⁴⁺:YAG 可饱和吸收体的能级图

Fig. 7 Energy level diagram of Cr⁴⁺ : YAG

具有激发态吸收的 Cr4+:YAG 可饱和吸收体 的能级结构和主要跃迁过程如图7所示,其中第一激 发态 3T2 包括两个能态,晶体中跃迁过程包括 3A2 到 $3T_2$ 的基态吸收和 $3T_2$ 到 $3T_1$ 的激发态吸收,室 温下 $3T_1$ 和 $3T_2$ 的能级寿命分别为 0.5 ns 和 4.1 μs^[10]。实验中 Cr⁴⁺:YAG 晶体初始透射率 $T_0 = 70\%$,其最大透射率为 $T_{\text{max}} = \exp(-n_0 \sigma_{\text{es}} l_s) =$ 90%,其中 n_0 为Cr⁴⁺:YAG 晶体基能态粒子密度, l_s 为晶体厚度1 mm, σ_{es} 为激发态吸收横截面积 2× 10^{-18} cm²。Cr⁴⁺:YAG 晶体的饱和能量密度为E_s= 270 μJ/mm², 实验中输出光束光斑半径约 0.25 mm,当Cr⁴⁺:YAG晶体内的能量密度达到饱 和时,对应的输出光束脉冲能量为7.95 µJ。也就是 说当单个脉冲的能量不足以使 Cr4+:YAG 晶体被 "饱和"或"漂白"时,其最大透射率就低于 T_{max},若谐 振腔内仍然可以满足增益大于损耗的阈值条件,依 然能够实现激光振荡输出,每次 Cr4+:YAG 晶体被 "漂白"的程度不同,会使得输出脉冲序列中脉冲幅 值的起伏较大,在实验中也观察到了这样的现象。 当脉冲能量较大时,输出脉冲的幅值基本平稳。

文献[7]对 AO 调 Q Nd: YVO4 激光器中 Cr⁴⁺: YAG 晶体被动 Q 开关对脉冲宽度的作用效果进行 了理论上的分析,指出与单 AO 调 Q 相比,主被动 双调 Q 的工作方式可以有效压窄输出脉冲的脉宽, 并在实验中当调制频率分别为 10 kHz 和 40 kHz 时,对单调 Q 和双调 Q 时的脉宽进行了测量比较, 验证了理论分析结果。对重复频率高于100 kHz情 况下的实验结果进行了测量,证实了在高重复频率 下主被动双调 Q 的工作方式依然可以压窄输出脉 冲的脉冲宽度。文献[11]从速率方程出发,对双调 Q 激光器输出脉冲能量最大时的优化参数进行了理 论计算,并从实验上进行了验证,但并未给出此时优 化条件下对脉冲宽度的影响,以上述工作为基础,对 双调 Q 激光器输出脉冲脉宽最窄时的优化参数的 理论分析工作正在进行中。

4 结 论

报道了一台采用 AO-Cr⁴⁺:YAG 主被动双调 Q 工作方式,工作在高重复频率下的 LD 端面抽运 Nd:YVO4激光器,在重复频率 125 kHz 下,抽运功 率 6.1 W时,得到了脉宽 7 ns 的输出,并对在高重 复频率下出现的实验现象进行了理论上的分析,指 出高重复频率下对 Cr⁴⁺:YAG 被动 Q 开关"饱和" 的不足是输出脉冲幅值波动较大的主要原因。

参考文献

1 M. J. F. Digonnet, C. J. Gaeta, Theoretical analysis of optical

fiber laser amplifiers and oscillators [J]. Appl. Opt., 1986, $\mathbf{24}(3):333{\sim}342$

- 2 Feng Yutong, Meng Junqing, Bi Jinzi *et al.*. High repetition rate, short pulse-width all-solid-state laser seed for fiber amplifier [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(8): 1173~1176
 冯宇彤,孟俊清,毕进子等.高重复频率、窄脉宽全固态光纤放 大器种子源[J]. 中国激光, 2008, **35**(8): 1173~1176
- 3 S. Du, J. Zhou, F. Zhang et al., 20-W average-power, high repetition-rate, nanosecond pulse with diffraction-limit from a all fiber MOPA system [J]. Microw. Opt. Techn. Lett., 2008, 50(10): 2546~2549
- 4 H. Plaessmann, Kevin S. Yamada, Charles E. Rich *et al.*. Subnanosecond pulse generation from diode-pumped acoustooptically Q-switched solid-state lasers [J]. *Appl. Opt.*, 1993, 32(33): 6616~6619
- 5 Z. Li, Z. Xiong, N. Mooreb *et al.*. Pulse width reduction in AO Q-switched diode-pumped Nd: YVO₄ laser with GaAs coupler[J]. *Opt. Commun.*, 2004, **237**(4): 411~416
- 6 G. Li, S. Zhao, K. Yang. Compression of the pulse width in a diode-pumped Nd: YVO₄ laser with double Q-switches[J]. Opt. Eng., 2005, 44(3): 034204
- 7 K. Yang, S. Zhao, G. Li *et al.*. Pulse compression in AO Qswitched diode-pumped Nd : GdVO₄ laser with Cr⁴⁺ : YAG saturable absorber[J]. Appl. Phys. B, 2005, 80: 687~692
- 8 Gao Liyan, Wang Chunxing, Tian Wenmiao *et al.*. Study of diode pumped double Q-switched Nd:GdVO₄ Laser[J]. *Laser & Infrared*, 2007, **37**(3):227~229 高利岩, 王春兴, 田文苗等. LD 泵浦双调 Q Nd:YVO₄激光器 实验研究[J]. 激光与红外, 2007, **37**(3): 227~229
- 9 G. Wang, S. Liu, L. Li *et al.*. Diode-pumped doubly *Q*-switched Nd:GdVO₄ Laser[J]. *Laser Phys.*, 2007, **17**(12): 1349~1352
- 10 Z. Burshtein, P. Blau, Y. Kalisky *et al.*. Excited-state absorption studies of Cr⁴⁺ ions in several garnet host crystals[J]. *IEEE J. Quantum Electron.*, 1998, **34**(2): 292~299
- 11 D. Li, S. Zhao, G. Li *et al.*. Optimization of doubly Q-switched lasers with both an acoustic-optic modulator and a Cr⁴⁺-doped saturable absorber [J]. *IEEE J. Quantum Electron.*, 2006, 42(5): 500~508